

BRF15N65 (CS15N65F)

N-CHANNEL MOSFET/N 沟道 MOS 晶体管

用途：适合高效率的开关式电源供应器和有源功率因数校正。

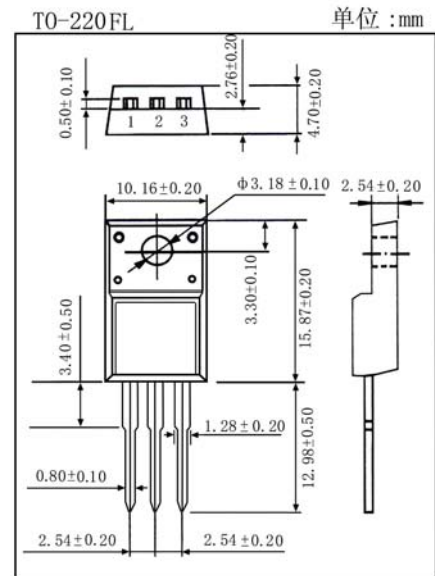
Purpose: These devices are well suited for high efficient switched mode power supplies and active power factor correction.

特点：低栅极电荷，低 Crss，快速开关，100%的雪崩测试，改进 dv/dt 能力。

Features: Low gate charge, Low Crss, Fast switching, 100% avalanche tested, Improved dv/dt capability.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{DSS}	650	V
I _D (Tc=25°C)	15	A
I _D (Tc=100°C)	9.5	A
I _{DM}	60	A
V _{GSS}	±30	V
E _{AS}	637	mJ
E _{AR}	25	mJ
I _{AR}	15	A
P _D (Tc=25°C)	73.5	W
T _J , T _{STG}	-55 to 150	°C



引脚： 1.G 2.D 3.S

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Conditions		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
BV _{DSS}	V _{GS} =0V	I _D =250 μ A	650			V
I _{DSS}	V _{DS} =650V	V _{GS} =0V			1.0	μ A
	V _{DS} =520V	T _C =125°C			10	μ A
I _{GSS}	V _{GS} =±30V	V _{DS} =0V			±100	nA
V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS}	I _D =250 μ A	3.0		5.0	V
R _{DS(on)}	V _{GS} =10V	I _D =7.5A		0.36	0.44	Ω
g _{FS}	V _{DS} =40V	I _D =7.5A		19.2		S
V _{SD}	V _{GS} =0V	I _S =15A			1.4	V
C _{iss}	V _{DS} =25V V _{GS} =0V f=1.0MHz			2380	3095	pF
C _{oss}				295	385	
C _{rss}				23.6	35.5	
t _{d(on)}	V _{DD} =325V I _D =15A R _G =21.7 Ω			65	140	ns
t _r				125	260	
t _{d(off)}				105	220	
t _f				65	140	

BRF15N65 (CS15N65F)

